

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2001110784
 PUBLICATION DATE : 20-04-01

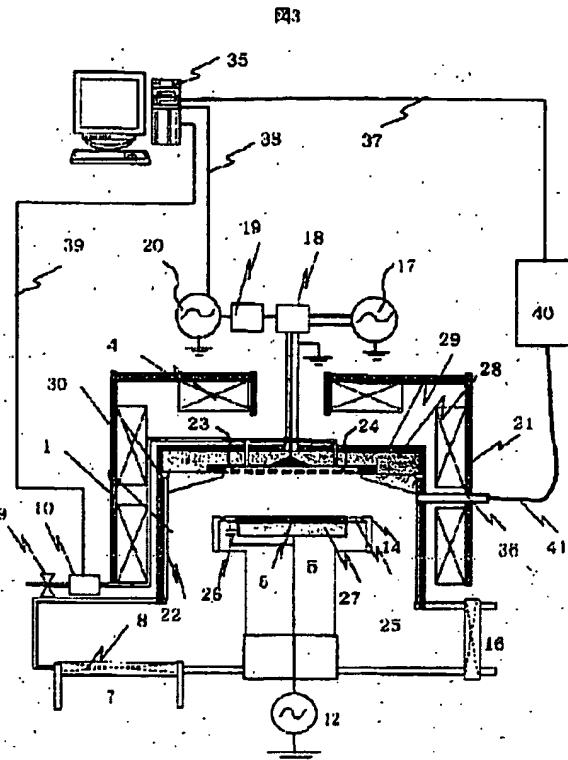
APPLICATION DATE : 12-10-99
 APPLICATION NUMBER : 11289148

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : TAJI SHINICHI;

INT.CL. : H01L 21/3065 C23F 4/00 H01L 21/768
 H05H 1/46

TITLE : APPARATUS AND METHOD FOR
 PLASMA TREATMENT



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an etching method for obtaining a fine machined shape, especially a vertical shape having less bowing when machining an insulating film in semiconductor manufacturing.

SOLUTION: Amount of O, F or N radical incident quantity that becomes excessive at the initial stage of etching is controlled with a gas flow rate or the consumption quantity of O, F and N in an inner wall face is controlled with etching time to suppress excessive O, F and N. The flow rate or consumption quantity is controlled, based on a plasma measurement result in etching and a stably etched shape is obtained. Etching rate and selectivity are maintained, and bowing can be reduced in the work of a hole and an organic film in an insulating film. Thus, a semiconductor device can be manufactured more finely.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-110784

(P2001-110784A)

(43)公開日 平成13年4月20日 (2001.4.20)

(51)Int.Cl'
H 01 L 21/3065
C 23 F 4/00
H 01 L 21/768
H 05 H 1/46

識別記号

F I
C 23 F 4/00
H 05 H 1/46
H 01 L 21/302

テマコード(参考)
E 4 K 0 5 7
Z 5 F 0 0 4
L 5 F 0 3 3
A
B

審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 11 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-289148

(22)出願日 平成11年10月12日 (1999.10.12)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 伊澤 勝

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 横川 賢悦

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

最終頁に続く

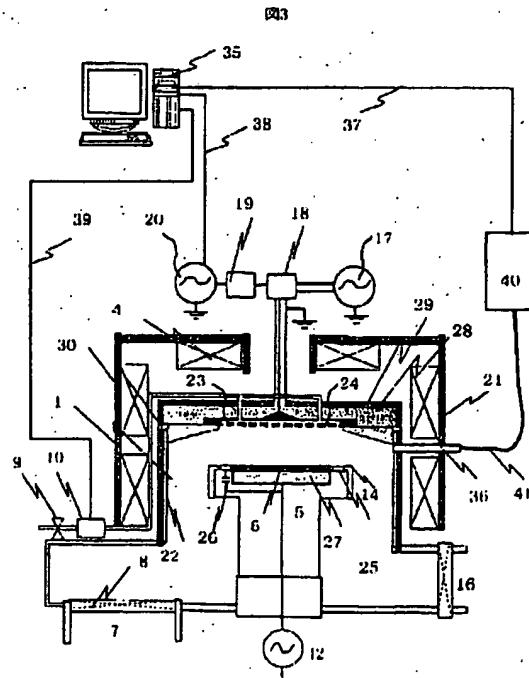
(54)【発明の名称】 プラズマ処理装置および処理方法

(57)【要約】

【課題】 半導体製造における絶縁膜加工において、微細加工形状、特にボーリングの少ない垂直加工形状が得られるエッチング方法を提供する。

【解決手段】 エッチング初期に過剰になるO₂、FもしくはNラジカル入射量をガス流量もしくはO₂、FおよびNを内壁面での消費量をエッチング時間とともに制御し、過剰なO₂、FおよびNを抑制する。さらに、安定したエッチング形状が得られるようにエッチング中のプラズマ計測結果を基に、上記流量もしくは消費量を制御する。

【効果】 エッチング速度および選択性を維持して、絶縁膜のホールおよび有機膜の加工においてボーリングが低減できるため、より微細な半導体デバイス製造が容易になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】真空排気手段により真空状態に保持される処理室において、前記処理室に設けられたガス導入手段によりガスを前記処理室に導入し、前記導入ガスを前記処理室内でプラズマ化する手段によって前記導入ガスをプラズマ化し、前記プラズマに被処理物に接触もしくは非接触の状態になるように前記被処理物を前記処理室内に設置することにより、前記被処理物を処理するプラズマ処理装置において、処理時間とともにプラズマ中のラジカル量を変化させることを特徴とするドライエッティング装置。

【請求項2】請求項1において電極もしくは前記高周波を導入するために設置されたアンテナを有し、前記電極もしくは前記アンテナに第2の高周波を印加する手段を有し、第2の高周波パワーを処理時間とともに変化させることによりプラズマ中のラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項3】請求項1においてガス流量を処理時間とともに変化させることによりプラズマ中のラジカル量を変化させることを特徴とするドライエッティング装置。

【請求項4】請求項1、2もしくは3において、被処理物の状態もしくはプラズマ中のラジカルを計測する手段を有し、前記計測する手段と同期してラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項5】請求項1、2、3および4において、変化させるラジカルがOもしくは、FもしくはNであることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項6】請求項1から5において、被処理物上に形成された絶縁膜をエッティングすることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項7】請求項6において、被処理物上に形成された絶縁膜が酸化膜で、プラズマの計測手段が発光計測器で、SiF/CF₂の発光強度比を計測することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項8】請求項6において、被処理物上に形成された絶縁膜が有機膜で、プラズマの計測手段が発光計測器で、CNの発光強度を測定することを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項9】請求項1から8において、第2の高周波を印加する電極もしくはアンテナがSiもしくはCを含むことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項10】請求項1から9において、プラズマを生成する高周波の周波数が300MHzから900MHzで、前記高周波を真空処理室内に設けられた平板アンテナを用いて導入し、真空処理室周辺に設けられたソレノイドコイルで磁場を印加し、電子サイクロトロン共鳴によりプラズマを生成し、平板アンテナと被処理物表面の距離が20mmから150mmであることを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項11】プラズマ処理室に高周波を導入し、プラズ

マを生成して被処理物をプラズマ処理するプラズマ処理方法において、処理時間とともにプラズマ中の解離ラジカル量を制御することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項12】請求項11において、電極もしくは前記高周波を導入するために設置されたアンテナに第2の高周波パワーを処理時間とともに変化させて印加することにより、プラズマ中のラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項13】請求項11においてガス流量を処理時間とともに変化させることによりプラズマ中のラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項14】請求項11、12もしくは13において、被処理物の状態もしくはプラズマ中のラジカルを計測する手段と同期してラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項15】請求項11、12、13および14において、変化させるラジカルがOもしくは、FもしくはNであることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項16】請求項11から15において、被処理物上に形成された絶縁膜をエッティングすることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項17】請求項16において、被処理物上に形成された絶縁膜が酸化膜で、プラズマ中のSiF/CF₂の発光強度比に同期してラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項18】請求項16において、被処理物上に形成された絶縁膜が有機膜で、プラズマ中のCNの発光強度に同期してラジカル量を変化させることを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項19】請求項11から18において、第2の高周波を印加する電極もしくはアンテナがSiもしくはCを含む材料であることを特徴とするプラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置の微細加工に用いるドライエッティング装置及びドライエッティング方法に関し、特に絶縁膜の高精度ドライエッティング加工を実現するドライエッティング装置及びドライエッティング方法に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体装置において、ウェハ上に形成されたトランジスタとメタル配線間およびメタル配線間を電気的に接続するために、トランジスタ構造上および配線間に形成された絶縁膜(SiO₂を主成分とする薄膜、以後、酸化膜と呼ぶ)に、ドライエッティング方法でコンタクトホールを形成し、コンタクトホール内に電気伝導体を充填する。ドライエッティングでは、エッティングガスを真空容器に導入し、このガスに高周波バイアスもしくはrf波を印加し、プラズマを発生させ、プラズマ中で生成した活性種およびイオンによって酸化膜を選択的に

エッティングし、コンタクトホールを形成する。このエッティングに際して、ホールパターンを転写したレジスト薄膜が酸化膜上に形成されている。このコンタクトホール加工では、レジスト膜、コンタクトホールの下部にある配線層、もしくは被エッティング膜とは別の絶縁膜、もしくはトランジスタを形成しているシリコンに対し選択的に酸化膜をエッティングする必要がある。

【0003】上記コンタクトホールの加工は、エッティング装置内に CF_4 、 CHF_3 、 C_4F_8 、 C_4F_6 、 C_6F_8 等のフロロカーボンガスおよび Ar ガスを導入し、0.5 Pa から 1.0 Pa のガス圧力条件で高周波プラズマ放電して、ウェハに 0.5 から 2.0 kV の Vpp 電圧が印加される条件でエッティングを行っている。配線層間の酸化膜が厚く、コンタクトホールのアスペクト比（深さ／直径）が高い場合には、ホール開口性を高めるため酸素ガスおよび CO ガスの添加、CO ガスの添加ではさらにレジストおよび塗膜に対する選択性を高める効果がある。

【0004】近年、半導体デバイスの高速化のため、配線材料として Cu が用いられ、配線間の絶縁膜として、有機絶縁膜、有機酸化ケイ素膜等の検討が進められている。有機絶縁では、窒素を含むガスが用いられ、有機酸化ケイ素膜では、酸化膜とほぼ同じガスが用いられる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のエッティング装置で、アスペクト比の高いコンタクトホールの加工を行う場合、エッティングが停止し非開口になる問題を避けるため、過剰に酸素ガスや CO ガスを添加する必要があった。CO が酸素ラジカルの供給源となるため、酸素ラジカルが過剰な条件でのエッティングになっていた。しかしながら、酸素ラジカルが過剰になるとホール上部では、側面に堆積膜が形成されず、マスク等で散乱されたイオンの入射により、ホール加工形状が広がってしまっていた。このホールの広がりは、ホール開口部（上部）より若干深い位置で発生する。詳細には、ホール開口部に比べホール径が広がり、ホール深さが深くなるに伴いホール径は小さくなる形状になる。すなわち、ホール中程でサイドエッティングが発生した加工形状になる。このようにホール径が広がる現象のことをボーアイングという。

【0006】ボーアイングが発生すると、ホール内に多結晶シリコンやタンクステン等の電気伝導体を充填する際に隙間ができ、半導体デバイスの不良の原因になる。このボーアイングは、ホールのアスペクト比が高くなると顕在化するため、半導体デバイスの微細化の障害となってきた。特に酸化膜エッティングでは、アスペクト比 6 以上でボーアイングが現れ、アスペクト比の増加とともにボーアイングが大きくなる。半導体デバイスの微細化が進み、アスペクト比 10 以上の加工必要となっているが、ボーアイング形状とのトレードオフにより微細化が難しくなっ

ている。

【0007】酸化膜以外の材料でも、同様にこのボーアイング現象は発生し、特に有機絶縁膜で顕著になる。条件にもよるが、有機絶縁膜および有機酸化ケイ素膜では、アスペクト比 2.5 度以上で顕在化する。これらの薄膜は配線間の絶縁膜として用いられるため、ホールアスペクト比は、微細なところで 5 から 10 度である。

【0008】ボーアイングを防ぐために、堆積性ガスを添加する場合があるが、エッティング速度が低下する等の副作用がある。

【0009】本発明が解決しようとする課題は、エッティング中にボーアイングを引き起こすラジカルを抑制することにより、ボーアイングを小さくして微細な絶縁膜加工を実現することである。

【0010】

【課題を解決するための手段】 C_4F_8 ガスと CO ガスによる酸化膜エッティングの場合、プラズマ中での解離により、 CF_2 、F、O および C が主に生じる（これら原子分子の名称にラジカルをつける場合があるが同じものである）。これ以外にも、 CF_3 、CF、 C_2F_6 、 C_3F_7 等も発生するがここでは本発明の概略に影響ないことから省略して説明する。 CF_2 、F、O および C のホール側面における付着係数 S は、 $S_{\text{C}} > S_{\text{F}} = S_{\text{O}} > S_{\text{CF}_2}$ となっている (S_{C} 、 S_{F} 、 S_{O} 、 S_{CF_2} はそれぞれ C、F、O および CF_2 の付着係数である)。ここで、便宜上 F や O についても付着係数を表したが、この付着係数は、堆積膜のエッティング確率に対応する。上記付着係数の関係を用い、Ar、 C_4F_8 、O₂、CO 混合ガスプロセスにおける側面付着量のホールアスペクト比依存性を求めた概念図を図 1 に示す。付着係数の関係により、C はマスクに対する保護膜となりうるが、曲線 102 に示すようにホールのアスペクト比が高くなるとホール内への到達量は激減する。一方、 CF_2 は、曲線 103 に示すようにホールのアスペクト比が高くなてもほとんど減少しない。これらに対し、F および O は、ホール上部で堆積性ラジカル C および CF_2 と反応するため、曲線 101 に示すようにアスペクト比の高いホールの場合底面付近への到達量が少なくなる。

【0011】アスペクト比の高いホールを加工するためには、過剰な CF_2 によるエッティング停止を抑制するため、O および F ラジカルを大量に供給する必要がある。このため、ホールの浅い部分では O および F ラジカルが過剰になり、C および CF_2 による側壁堆積膜がほとんど形成されない。このため、ホール上部で散乱されたイオンがホール側面に入射すると、 SiO_2 膜がエッティング（もしくはスパッタ）されボーアイングを引き起こすのである。C および CF_2 で形成された堆積膜が 2F および O でエッティングされると想定する場合、図 2 の曲線 201 に示すような加工形状の寸法シフトが生じる。ここで、負の寸法シフトがボーアイングである。ボーアイングが

アスペクト比3、5程度で生じる。

【0012】同一条件でホールをエッチング（以後、無制御エッティングと呼ぶ）する場合、アスペクト比の最も高いホールにFおよびOラジカルの量を合わせる必要がある。しかしながら、ホールアスペクト比は、エッチングの進行に伴い増加するため、エッチング初期では、レジスト膜厚を加えても、直径0.2μm以下のアスペクト比3程度である。この初期アスペクト比は、デバイスの微細化が進むになるとレジスト膜厚が薄くなるため、半導体デバイスの世代によってあまり変わらない。このように、初期のアスペクト比が小さいことから、無制御エッティングでは、エッチング初期には、FおよびOが過剰になっている。

【0013】以上のような理由から、O₂流量およびCO流量をエッティング時間の進行とともに増加させれば、ボーリングを低減できる。O₂を流量0ml/minから8ml/minに、CO流量を50ml/minから120ml/minに、時間に比例して増加させた場合の加工形状の寸法シフトを図2曲線202に示す。このように、過剰なOを低減することによりボーリングが著しく低減する。

【0014】しかしながら、単に流量を時間変化させたのでは、装置の状態に依存したエッティング停止の発生、流量の応答が遅いため、制御方法が配管の長さ、流量コントローラの機種等に依存する。これらに対応する手段として、酸化膜エッティングの進行をモニタし、このモニタデータを基に流量を制御する方法、バイアス印加等の応答時間の短いものを用い、過剰なFおよびOを除去する方法、さらにこれらを組み合わせた手法等が有効である。エッティングの進行をモニタする方法としては、プラズマの発光スペクトル、光学的な膜厚測定器、質量分析器、レーザー導入発光スペクトル等が上げられる。また、2つ以上の電子温度領域を制御できる場合、電子温度領域の幅の制御によりFの解離をコントロールする手段がある。

【0015】有機ケイ素膜および有機絶縁膜においては、過剰なOもしくはFもしくはC1によりボーリングが発生するほか、過剰なNラジカルでも同様にボーリングが発生する。したがって、O、F、C1およびNのいずれかを過剰なラジカルを抑制することによりボーリングは低減される。

【0016】本発明は、酸化膜エッティングにおいてエッティング時間の進行とともに、OおよびFラジカル入射量を調整し、ボーリングを抑制し垂直かつアスペクト比の高い加工形状が得られるエッティング方法を提供するものである。有機物を含む絶縁膜のエッティングにおいては、この他、Nラジカルの入射量を調整することにより、ボーリングを抑制し垂直かつアスペクト比の高い加工形状が得られるエッティング方法を提供するものである。

【0017】

【発明の実施の形態】（実施例1）図3の装置を用いた実施形態について説明する。この装置では、プラズマ処理室1の内部にアンテナ23、アンテナ誘電体28、および処理台5が設置されている。プラズマ処理室1にエッティングガスをアンテナ23に設けられたガス導入口24から導入し、高周波電源17において生成した300MHzから900MHzの間の高周波をアンテナ23からプラズマ処理室35に導入してガスプラズマを発生させる。効率よくプラズマ処理室に効率良く高周波が伝搬するように、アンテナ23とアンテナアース29の間で高周波が所望のモード（ここでは、TM01）で共鳴するようアンテナの外径とアンテナ誘電体28の材質が決められている。高周波はアンテナとアンテナアースの間で共鳴し、アンテナ誘電体の周辺部よりプラズマ処理室に伝搬される。高効率放電のために磁場発生用のソレノイドコイル4をプラズマ処理室周辺に3つ配置し、Oから320ガウスの間の磁場が処理台のはば真上にくるよう2つのコイル電流を制御し、エレクトロンサイクロトロン共鳴（ECR）を用いて電子密度が10¹¹個/cm³以上の高密度プラズマを発生させる。プラズマ処理室1には処理台6があり、この上に被処理物6を設置して、ガスプラズマによりエッティング処理する。エッティングガスは、ガス流量コントローラ10を通してプラズマ処理室1に導入され、排気ポンプ7によりプラズマ処理室1の外に排気される。被処理物を設置する処理台5には高周波電源12を備え、400KHzから13.56MHzまでの高周波バイアスを印加できる。処理台の位置は、アンテナから距離が20mmから150mmの範囲で固定することができる。処理台5の周辺に幅30mm程度（5mm以上100nm以下で被処理物周辺のF消費効果がある）のフォーカスリング25がウエハ周辺部に設置できる構造になっており、このフォーカスリングにウエハに印加される高周波がコンデンサー26で分岐して10%から20%程度印加されるようになっている。このフォーカスリングは、下部がAlで上部が結晶Siの2層構造で、不純物ドープされたSiやSiCを設置することもできる。アンテナ23には、高周波電源17とは異なる周波数（10kHzから27MHz）が印加できるように、フィルター回路19に高周波電源20が接続されている。アンテナ23の材質は、プラズマ処理室側は、不純物ドープされたSiで、その反対側はAlである。

【0018】この装置に、被処理物として図4に示す構造を持つ8インチシリコンウエハを搬送する。シリコンウエハ406上には厚さ4nmのゲート酸化膜405、その上の一部に多結晶SiとWで形成された厚さ200nm幅100nmのゲート電極404が形成されている。ゲート電極とゲート酸化膜上には、厚さ（最も厚い部分で）2000nmの酸化膜403（SOGとCVD酸化膜）が形成されている。その上部には、厚さ80nmの反射防止膜402と直径120nmのホールパターンが

露光現像されたレジストマスク401が500nm形成されている。ゲート電極間にある酸化膜の幅は約160nmである。反射防止膜は、N₂とCF₄混合ガスプラズマによりすでにエッチングされている。

【0019】この装置に、Ar 1250ml/min, C₂F₆を24ml/min, O₂を30ml/minをガス導入口よりプラズマ処理室に導入しガス圧力を2.5Paにする。450MHz, 1.8kWの高周波によりガスプラズマを生成し、処理台に800kHz, 2000Wのバイアスを印加し、酸化膜をエッチングする。ウエハ表面からウエハ対向面であるアンテナ23までの距離（ギャップ）が50mmになるように処理台の高さを調整し、ウエハ中心の真上35mmの位置およびウエハ周辺の真上40mmの位置で磁場強度が160ガウス、その位置における磁場勾配が8ガウス/cmとなるようにコイル電流を調整する。アンテナには、13.56MHzの高周波バイアスを200W印加する。

【0020】この条件で、120nm径のホールの酸化膜エッチング速度は約700nm/minで、レジストに対する選択比は8程度である。エッチングは約170秒で底面のSiに到達するが、コンタクトを確実にするため、トータルで約220秒間エッチングを行う。この時の加工形状は、図4の加工形状408となり、ホール上部で酸素過剰により、ポーリングが発生する。ポーリング位置の寸法シフトは20nm程度である。O₂流量の加工するホールのアスペクト比に依存し、アスペクト比10では、エッチングが終了するまでにO₂流量を初期流量に対し60%増加、アスペクト比20では120%程度増加させる必要がある。

【0021】ポーリングを低減するため、O₂流量をエッチング開始時に1.5ml/minとし、エッチングが10秒進む毎に0.8ml/minのO₂流量を増加させ、O₂流量30ml/min以降は一定になるよう制御する。この条件でエッチングを行うと、エッチング初期に過剰な酸素が少なくなるため、保護膜が形成されポーリングが大幅に抑制され、図4の加工形状409のごとくエッチングされる。エッチング中のトータルのOラジカル入射量も少なくなるので、レジストマスクの残膜量も30%程度多くなる。

【0022】上記、O₂流量の制御は、エッチング停止ぎりぎりのO₂流量であるため、プロセスの安定性が懸念される。プロセスの安定性をより確実なものにするため、発光スペクトラルを測定しながら、O₂流量を制御する。図1の装置に発光分光器40を光ファイバ41を通して真空処理室に設置された窓36に接続し、分光器40と制御用コンピュータ35をデータ線37で接続する。発光分光器では、酸化膜のエッチャントであるCF₂(280nm付近)と反応生成物SiF(440nm付近)の発光を観測する。エッチング停止が発生すると、CF₂が増え、SiFが減少する。精度を上げるた

め、SiF/CF₂発光比の減少によりエッチング速度の低下がわかる。比エッチング面積5%程度では、エッチングの有無によりこの発光強度比は10%程度変化する。この発光強度比の変化によりO₂流量を増加させることにより、装置状態が多少変化しても、エッチング停止の問題なく、安定してポーリングの少ない加工形状を得ることができる。ここでいう、装置状態とは、真空処理室内壁面の堆積物の厚さ、長時間使用後の状態、装置間の微妙な差のことである。

【0023】図3の装置においてガス流量コントローラ10を制御用コンピュータ35に接続し、O₂流量を発光強度比を基に制御する。エッチング条件は、上記とし、O₂初期流量を1.5ml/minとし、最大O₂流量を30ml/minとする。

【0024】上記エッチング条件に対し、SiF/CF₂発光強度比が約1秒間に0.5%減少するとO₂流量を1ml/min増加するように制御コンピュータで流量を制御する。O₂流量は順次増加し、最大の30ml/minになる。この制御を用いると装置の状態に依存せずポーリングの少ないエッチング加工形状を得ることができる。同時にレジストマスクの残膜量も増える。

【0025】発光スペクトラルは、他の波長のCF₂およびSiFを用いても同様な制御が可能である。発光強度としては、この他、C₂の変化で制御することも可能である。さらに、有機酸化ケイ素の場合、COやOの発光強度の変化で制御してもよい。

【0026】Oラジカルの入射量を低減する方法として、装置内にOラジカルを消費させる機構を設ける手段がある。図3の装置で、アンテナ23の材質を不純物ドープしたSiCを用いると、アンテナバイアス印加によりCとOが反応しOが消費される。したがって、アンテナバイアスを調整し、O入射量がコントロールできる。特に、この場合、ウエハとアンテナの距離が短い方がアンテナでの消費効果が大きく、ウエハとアンテナ表面の距離を130mm以上になると、アンテナの反応生成物が再解離しOを発生するため好ましくない。

【0027】上述と同じガスを用い、Ar 1250ml/min, C₂F₆を24ml/minでO₂流量を25ml/minとする。アンテナバイアスパワー以外の条件は上記と同じとする。エッチング開始時にアンテナバイアスパワーを800Wとする。アンテナSiCの削れ量はアンテナバイアスパワーに比例するので、Oの消費量もほぼこれに比例する。アンテナバイアスを800Wから10秒毎に約40Wづつ100Wになるまで低減する。このアンテナバイアスの調整により過剰なOラジカル量は抑制され、ポーリングがほとんど生じない。同時にレジストマスクの残膜量も増える。

【0028】アンテナバイアスは、電源と制御コンピュータを接続することにより、CF₂/SiF発光強度比の変化で制御する場合、同様な結果が得られると同時

に、安定した加工形状が得られる。

【0029】抜け性を確保する（エッティング停止を防ぐ）ガスとしてO₂の代わりに、C₂F₆、SiF₄、SF₆、CF₃OF、CF₂(OF)₂、CF₃I等のF含有ガスを用いても同様な結果が得られる。Fラジカルで抜け性を確保する場合、アンテナとして、SiCの代わりにSiを用いても同様な結果が得られる。この他、COガスでも同様な効果が得られる。N₂ガス添加により抜け性を確保する場合、CおよびSiCのアンテナを用いてもよい。

【0030】アンテナで過剰FおよびOを除去する場合、アンテナ材としてC、導電性有機物等でも同様な効果が得られる。バイアスが印加される程度の厚さであればアンテナ材として絶縁体を用いてもよく、厚さ2から6mm程度のポリイミド板、セラゾール板等の有機物、および不純物の少ないSiC板でも同様な効果が得られる。

【0031】エッティングガスとしてC₂F₆に限らず、CHF₃、C₂F₄、C₃F₆、C₄F₈、C₅F₈、C₆F₆、C₂F₄H₂、C₂F₆H、C₃F₆H₂、C₃F₇Hを用いても同様な効果が得られる。希釈ガスとしては、Arに限らず、He、Ne、KrもしくはXeガスを用いてもよい。

【0032】Fの発生量を制御する方法として、プラズマのECR領域以外の電子温度が低い部分Fが選択的に発生することから、ECR領域の磁場勾配を制御しFラジカルの量を制御することによっても同様な効果が得られる。ECR領域の広がりは、磁場勾配に反比例するので、エッティング初期は磁場勾配を小さくし、エッティングの経過とともに磁場勾配を大きくすればよい。この際、イオンの入射量が磁場勾配を大きくすると小さくなるので、プラズマを生成するための高周波パワーを同時に大きくする必要がある。具体的には、高周波(UHF)の周波数が450MHzの場合、ウエハ中心上部の磁場強度が160Gになる位置における磁場勾配を4G/cmから20G/cmに時間経過とともに増加させ、同時にUHFパワーを1.6kWから2.0kWに高くすればよい。磁場勾配を発光スペクトルで上記のごとくコントロールしてもよい。

【0033】ウエハとウエハ対抗面（アンテナ）の距離を調節しても上記と同様な結果が得られる。

【0034】被エッティング膜が有機酸化ケイ素膜の場合も同様な効果が得られる。

【0035】（実施例2）図5の装置を用いた別の実施形態について説明する。この装置では、図3の装置で下部電極の高周波電源12からパワー分配機43でパワーを分割し位相を調整してアンテナにバイアスが印加できる構造になっている。

【0036】この装置に、被処理物として図6に示す構造を持つ8インチシリコンウエハを搬送する。図には記

載していないが、シリコンウエハ上にはトランジスタ構造がありその上には酸化膜層607で覆われている。酸化膜607の上には、Cu配線608が形成されその周辺は、酸化膜605および有機絶縁膜606で覆われている。Cu配線の上には厚さ500nmの有機絶縁膜604、厚さ50nmの酸化膜603が形成され、有機絶縁膜の上下部は絶縁物の接着剤で接合されている。さらにその上部には、厚さ80nmの反射防止膜602と直径150nmのホールパターンが露光現像されたレジストマスク601が600nm形成されている。反射防止膜は、N₂とO₂の混合ガスプラズマによりすでにエッティングされている。

【0037】この装置に、Ar 500ml/min、C₂F₆を20ml/min、O₂を10ml/minをガス導入口よりプラズマ処理室に導入しガス圧力を2.0Paとして酸化膜をエッティングする。次に有機絶縁膜をエッティングするため、NH₃ガスを100ml/min導入し、ガス圧力を3Pa、電源周波数を450MHzとし、パワー1.0kWをアンテナより導入しガスプラズマを生成する。アンテナには、800kHzの高周波バイアスが100W印加されるように分配機43のコンデンサおよびコイルを調整する。ウエハ表面からウエハ対向面であるアンテナ23までの距離（ギャップ）が70mmになるように処理台の高さを調整し、ウエハ中心の真上35mmの位置およびウエハ周辺の真上50mmの位置における磁場強度が160ガウス、ウエハ中心上の磁場強度160ガウスの位置における磁場勾配が12ガウス/cmとなるようにコイル電流を調整する。処理台に400kHz、300Wのバイアスを印加し、有機膜をエッティングする。

【0038】この条件で、150nm径のホールの酸化膜エッティング速度は約500nm/minで、レジストに対する選択比は1.3程度である。エッティングは約60秒で底面のCuに到達するが、コンタクトを確実にするため、約80秒エッティングする。この時の加工形状は、ホール上部でのN過剰により、ボーリングが発生する。

【0039】HはNと側面で反応してNを除去する効果があるので、エッティング初期にH₂を24ml/min添加し、10秒毎に4ml/minずつ減らす。導入するNの量に対し、エッティング初期に5%から50%のH₂を添加すると効果がある。エッティング初期の過剰Nが少なくなり、図6の加工形状610に示すようにボーリングが少ない加工形状が得られる。H₂の代わりにCH₄、C₂H₆、C₂H₂、CH₃OH等を用いても同様であり、かつこれらの添加ガスが可燃性であることからAr等の希ガスで希釈しても同様な結果が得られる。エッティングガスとしてNH₃を用いたが、N₂とH₂の混合ガスでも同様に、H₂流量の調整でほぼ同じ効果が得られる。エッティングガスとしてN₂とO₂を用いる場合は、O

の反応性が高いので、O₂流量の調整で同様な効果が得られる。

【0040】アンテナ材としてCもしくはSiCを用いる場合、アンテナバイアスの調整により、上記酸化膜エッティングの場合と同様に過剰Nもしくは過剰Oを抑制することにより、ポーリングの少なく加工形状が得られる。

【0041】発光スペクトルによってアンテナバイアスもしくはガス流量を調整する場合、CN発光強度がエッティング速度に関連づけられるので、CNの発光強度が小さくなるに伴い、H₂、CH₄等の流量を減少させればよく、O₂流量の場合CN発光強度が小さくなるに伴い、増加させると、ポーリングが小さく抑えられる。

【0042】上記は、有機絶縁膜のホール加工に適用したが、溝パターンの加工においても同様にポーリングを小さくすることができる。

【0043】(実施例3) 次に図7の装置を用いた別の実施形態について説明する。この装置ではプラズマ処理室1にガス導入口6よりエッティングガスを導入し、第一の高周波電源61および第二の高周波電源62において0.5-1.5MHzの間の高周波を発生させ、この高周波をリングアンテナ(もしくはループアンテナ)63、64からそれぞれセラミック材料65を通してプラズマ処理室1に導入してガスプラズマを発生させる。プラズマの電子密度は10¹¹個/cm³以上の高密度プラズマになる。プラズマ処理室1には処理台5があり、この上に被処理物6を設置して、ガスプラズマによりエッティング処理する。エッティングガスは、ガス流量制御装置を通してプラズマ処理室1に導入され、排気ポンプ7によりプラズマ処理室1の外に排気される。被処理物を設置する処理台5には高周波電源12を備え、400kHzから13.56MHzまでの高周波バイアスを印加できる。ウエハ対面は、不純物を含むSiとSiCが各々約30%と約70%のセラミック材料65で、接地面である。ウエハとセラミック材料の内面までの距離は20mmから150mmの間で調整できるように処理台5に上下機構が設置されている。

【0044】この装置に、被処理物として8インチシリコンウェハを搬送する。このシリコンウェハ上には厚さ2μmの酸化膜が形成されその上部にはマスクパターンを転写したレジストマスクが形成されている。レジストマスクには、150nm径のホールが形成されている。

【0045】この装置に、Ar 50ml/min、C₃F₈を20ml/min、Si(OCH₃)₂F₂を4ml/minガス導入口より処理室に導入しガス圧力を0.7Paとし、ウエハとセラミック材料内壁面までの距離を70mmとなるように処理台を調整する。1.8MHzの1000Wの高周波を第一のリングアンテナ63に印加し、2.2MHzの700Wの高周波を第二のリングアンテナ64に印加し、ガスプラズマを発生させ、処理台に2MHz、12

00Wのバイアスを印加し、酸化膜をエッティングする。この条件では、エッティング速度は約600nm/minであるが、ボーリングが発生する。

【0046】過剰なFを低減するため、エッティング中に、Si(OCH₃)₂F₂流量を1.4ml/minから4ml/minに減らしてエッティングを行う。流量の変化量は20秒毎に1ml/minとした。過剰なFがSiおよびCH₃で除去されるため、ボーリングは大幅に低減する。

【0047】ガス種としてはSi(OCH₃)₂F₂の他に、Si(CH₃)₂F₂、Si(CH₃)₂Cl₂、Si(OCH₃)₂Cl₂、Si(CH₃)₃H、Si(CH₃)₂H₂、SiH₄、Si₂H₆、SiCl₂H₂等でもよい。

【0048】エッティングガスとしてC₃F₈に限らず、CHF₃、C₂F₄、C₃F₆、C₄F₆、C₄F₈、C₅F₆、C₅F₈、C₆F₆、C₂F₄H₂、C₂F₅H、C₃F₆H₂、C₃F₇Hを用い、ホール抜け性を確保するためO₂添加する場合でも同様な効果が得られる。希釈ガスとしては、Arに限らず、He、Ne、KrもしくはXeガスを用いてもよい。

【0049】発光スペクトルの測定装置とマスフローコントローラを図3に示したのと同様に接続すれば、発光スペクトルで流量を制御することも可能である。

【0050】エッティングガスとしては、実施例1で用いるガスを用いても、実施例1と同様な制御でボーリングを低減することができる。

【0051】実施例で用いた装置の他、図7で示す空洞共振器を持つエッティング装置や、図8に示す大気アンテナのエッティング装置、平行平板型の装置でも同様な効果が得られる。図7および図8の装置には、プラズマが接触する部分にアンテナ等の電極が無いので、プラズマ処理室内にSi板、SiC板、C板等を設置し、これに高周波バイアスを印加することで、アンテナと同様な効果を得ることができる。

【0052】

【発明の効果】本発明により、エッティング中のFおよびラジカル入射量が適性に制御されるため、エッティング速度および選択性を維持して、ボーリングを抑制されるため、アスペクト比の高いコントラクトホールおよび有機物を含む薄膜のエッティングにおいて、高い垂直加工形状が得られる。

【0053】本発明により、半導体デバイスの微細ホール加工および絶縁膜の溝加工で垂直性が向上するため、デバイスの不良が少なくなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明で用いるホール側面に付着もしくは反応するラジカル量のホールアスペクト比に対する依存性を示す概念図である。

【図2】本発明で用いる寸法シフトのホールアスペクト比依存性を示す図である。

【図3】本発明で用いるドライエッティング装置の断面お

および制御コンピュータとの接続を示す図である。

【図4】本発明で用いる被処理物上の酸化膜ホールの加工前と加工後の形状の断面図である。

【図5】本発明で用いる別のドライエッティング装置の断面および制御コンピュータとの接続を示す図である。

【図6】本発明で用いる被処理物上の有機膜ホールの加工前と加工後の形状の断面図である。

【図7】本発明で用いる別のドライエッティング装置の断面図である。

【図8】本発明で用いる別のドライエッティング装置の断面図である。

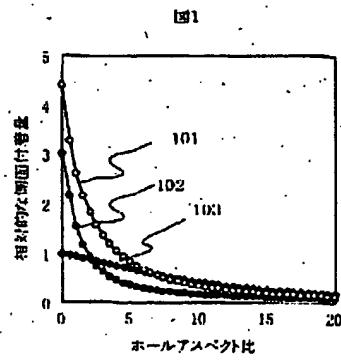
【図9】本発明で用いる別のドライエッティング装置の断面図である。

【符号の説明】

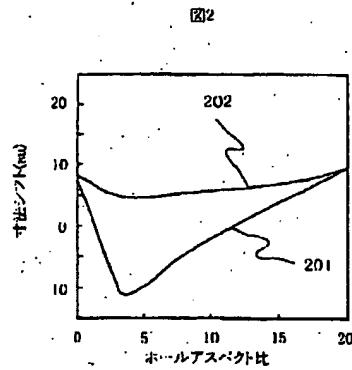
1. プラズマ処理室、2. マイクロ波発生器、3. 導波管、4. ソレノイドコイル、5. 処理台、6. 被処理物、7. 排気ポンプ、8. 排気バルブ、9. コンダクタスバルブ、10. ガス流量コントローラ、11. ガス導入口が形成された誘電体、12. 処理台用の高周波電源、13. 石英の真空容器、14. アルミナのセプタ、16. 搬送用ゲートバルブ、17. 高周波電源、18. スタブチューナー、19. 高周波フィルタ、20. 第3の高周波電源、21. ヨーク、22. アルマイト処理したAl内筒、23. 平板アンテナ、24. ガス導入口、25. Siフォーカスリング、26. コンデンサー、27. 被処理物に高周波を印加するために設けられたA-I電極、28. アンテナ誘電体、29. アンテナア

- ース、30. 金属の真空容器、31. 高周波導入窓、32. 空洞共振器、33. 石英板、34. 大気アンテナ、35. 制御用コンピュータ、36. 光ファイバー用の窓、37. 分光器の信号線、38. アンテナバイアス制御用の信号線、39. ガス流量制御用の信号線、40. 分光器、41. 光ファイバーケーブル、42. 高周波分配器の制御用信号線、43. 高周波分配器、101. FとOのホール側面における反応量の和を示す曲線、102. Cのホール側面における付着量を示す曲線、103. CF₂のホール側面における付着量を示す曲線、201. 従来プロセスによるホールの寸法シフト量を示す曲線、202. 本発明によるホールの寸法シフト量を示す曲線、401. 露光処理したレジストマスク、402. 反射防止膜、403. 酸化膜、404. ゲート酸化膜、405. ゲート電極、406. 不純物ドープしたシリコンウエハ、407. 加工前のウエハの断面図、408. 従来プロセスによる加工後のウエハ断面図、409. 本発明による加工後のウエハ断面図、601. 露光処理したレジストマスク、602. 反射防止膜、603. 第一の酸化膜、604. 第一の有機薄膜、605. 第二の酸化膜、606. 第二の有機薄膜、607. 第三の酸化膜、608. Cu膜、609. 加工前の被処理物の断面図、610. 本発明による加工後の被処理物の断面図、611. 第一の高周波電源、612. 第二の高周波電源、613. 第一のリングアンテナ、614. 第二のリングアンテナ、615. セラミック材料、616. ガス導入口。

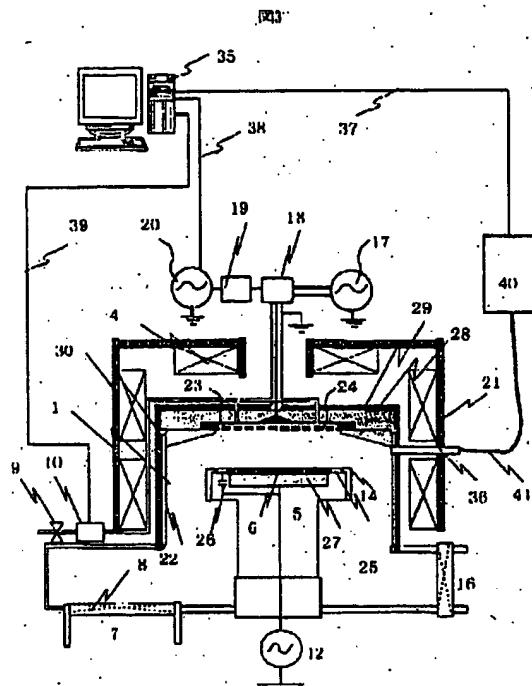
【図1】



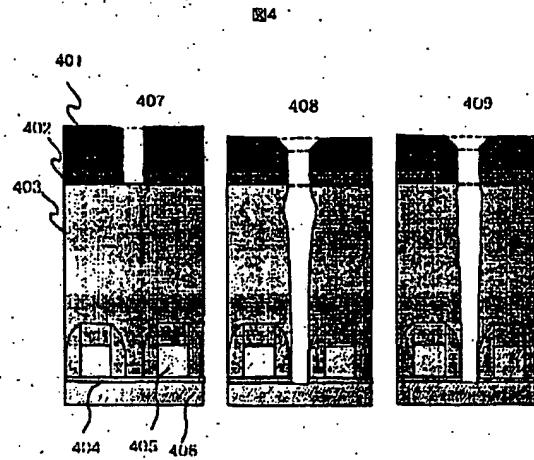
【図2】



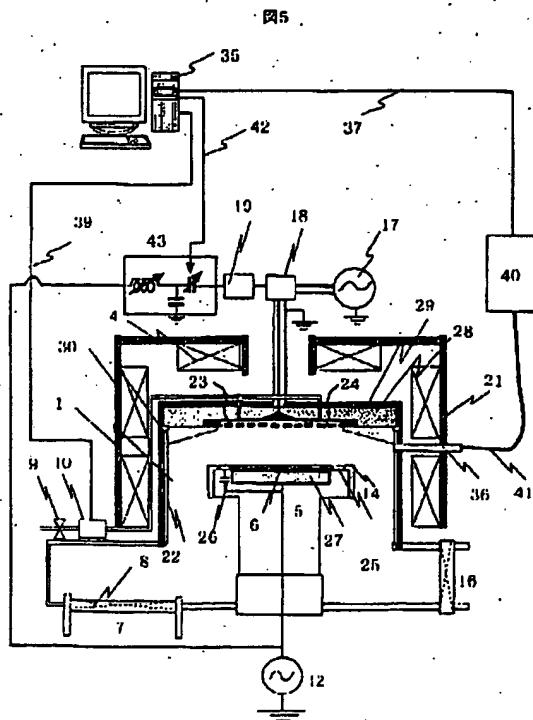
【図3】



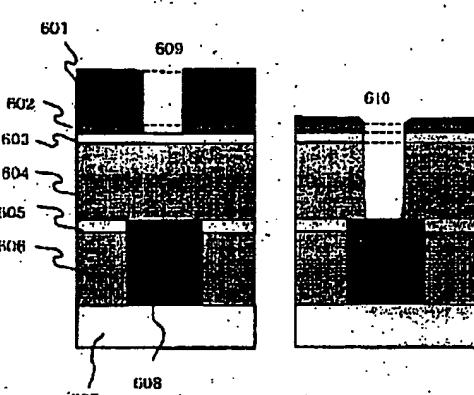
【図4】



【図5】

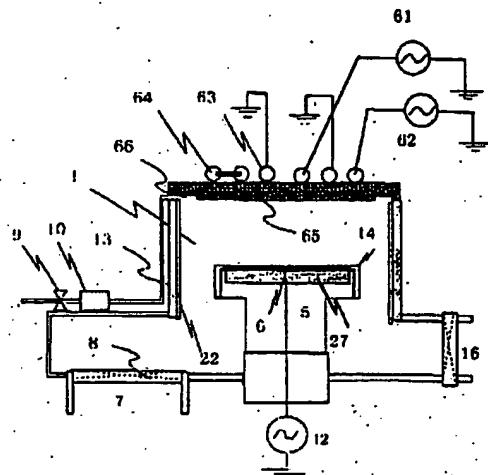


【図6】



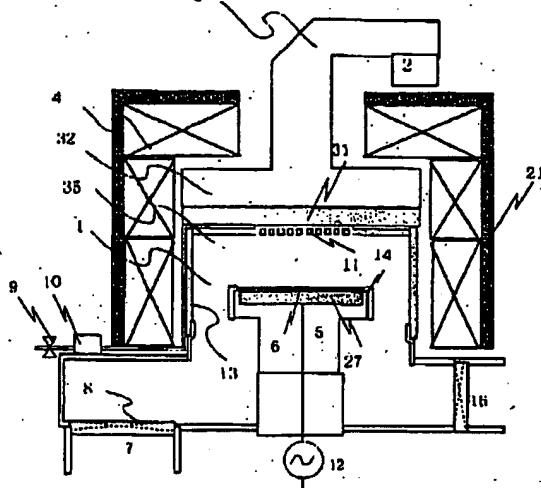
【図7】

図7



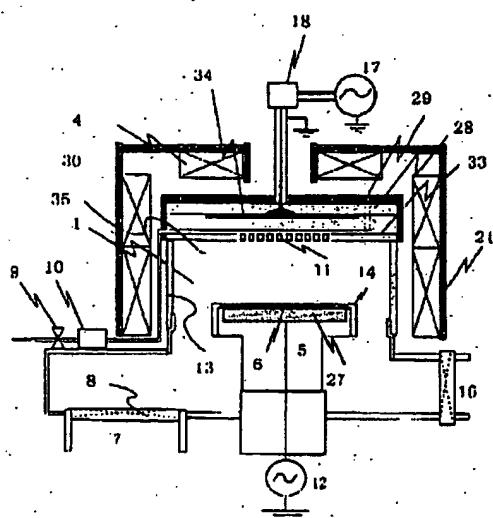
【図8】

図8



【図9】

図9



フロントページの続き

(51) Int.Cl. 7

H 05 H 1/46

識別記号

F 1

H 01 L 21/90

テ-73-ト(参考)

A

(72)発明者 根岸 伸幸

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 桃井 義典

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 田地 新一

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地
株式会社日立製作所中央研究所内

Fターム(参考) 4K057 DA11 DA12 DA13 DB20 DD01
DD08 DE06 DE14 DG07 DG12

DG15 DN01.

5F004 BA14 BB07 BB11 BB13 BB29
BC03 CA02 CA03 CA06 CA08
CB02 CB04 CB10 DA00 DA01
DA02 DA03 DA18 DA24 DA26
DB03 EA22

5F033 KK01 KK11 QQ09 QQ12 QQ15
QQ37 RR04 RR09 RR21 SS11
TT04 WW01 WW06 WW07 WW10
XX00

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.